

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成 23 年 7 月 28 日 (2011.7.28)

【公開番号】特開 2009-56584 (P2009-56584A)

【公開日】平成 21 年 3 月 19 日 (2009.3.19)

【年通号数】公開・登録公報 2009-011

【出願番号】特願 2008-209138 (P2008-209138)

【国際特許分類】

B 2 4 B 37/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

【F I】

B 2 4 B 37/00 C

B 2 4 B 37/00 T

H 0 1 L 21/304 6 2 2 F

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 6 月 10 日 (2011.6.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を研磨するための形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドであって、

稠密化状態に固定された研磨層を含み、

研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を含み、

研磨層は、形状記憶マトリックス材料がその本来の形状にあるときの本来の厚さ O T を示し、

研磨層は、形状記憶マトリックス材料がプログラム形状にされたときの稠密化状態での稠密化厚さ D T を示し、

D T O T の 8 0 % であり、

研磨層が、基材を研磨するために適合された研磨面を有するものである形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド。

【請求項 2】

研磨層が 2 0 ~ 1 5 0 ミルの稠密化厚さを有する、請求項 1 記載の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド。

【請求項 3】

研磨層が、基材の研磨を促進するためのマクロテキスチャを示し、マクロテキスチャが穿孔及び溝の少なくとも一つを含む、請求項 1 記載の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド。

【請求項 4】

形状記憶マトリックス材料が網状ネットワークを形成する、請求項 1 記載の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド。

【請求項 5】

研磨層が、中空コアポリマー材料、液体充填中空コアポリマー材料、水溶性材料及び不溶性相材料から選択される複数の微小要素をさらに含む、請求項 1 記載の形状記憶ケミカル

ルメカニカル研磨パッド。

【請求項 6】

複数の微小要素が、研磨層全体に均一に分散した中空コアポリマー材料を含む、請求項 5 記載の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド。

【請求項 7】

形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する方法であって、
本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提供すること、
本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さ O_T を示す本来の状態にある研磨層を調製すること、
研磨層を外力に付すこと、
形状記憶マトリックス材料をプログラム形状にセットして、稠密化厚さ D_T を示す稠密化状態にある研磨層を提供すること、
外力を解除すること
を含み、
 D_T / O_T の 80 % であり、
研磨層が、磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を研磨するために適合された研磨面を有するものである方法。

【請求項 8】

複数の微小要素を提供すること、
複数の微小要素を形状記憶マトリックス材料中に分散させること、
研磨層を、形状記憶マトリックス材料のガラス転移温度 T_g よりも高い温度 T まで加熱すること
をさらに含み、
外力が、研磨層の温度を形状記憶マトリックス材料の T_g よりも高い温度に維持しながら研磨層を稠密化厚さ D_T まで軸方向に圧縮する軸方向力であり、形状記憶マトリックス材料が、軸方向力を維持しながら研磨層を形状記憶マトリックス材料の T_g 未満の温度まで冷却することによってプログラム形状にセットされる、請求項 7 記載の方法。

【請求項 9】

基材を研磨する方法であって、
磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を提供すること、
稠密化状態に固定された研磨層を含み、研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を含み、本来の状態にある研磨層は、形状記憶マトリックス材料が本来の形状にあるときの本来の厚さ O_T を示し、研磨層は、形状記憶マトリックス材料がプログラム形状にされたときの稠密化状態での稠密化厚さ D_T を示し、
 D_T / O_T の 80 % である形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを提供すること、及び
研磨層の研磨面と基材との間に動的な接触を形成して基材の表面を研磨すること
を含む方法。

【請求項 10】

研磨層のうち、少なくとも研磨面に隣接する部分を活性化刺激に暴露することによって研磨層の研磨面をコンディショニングすること
をさらに含み、
研磨層のうち、活性化刺激に暴露された研磨面に隣接する部分が稠密化状態から復元状態に転移する、請求項 9 記載の方法。